

既刊特許分析レポートのご案内

(株) キャップインターナショナル

バイタルサインセンシング技術に関する特許分析と事業化動向 Part.1 日本特許編

冊子版 定価:120,000円、冊子+CD版:定価:180,000円(税別) A4判 289ページ 2015年8月発刊
収録特許件数 1305件 検索期間(出願日/公開公報発行日):2000年1月~2014年12月末

血糖値センサー技術に関する特許分析と事業化動向 — 非侵襲型SMBGとCGMの実現 —

冊子版 定価:120,000円、冊子+CD版:定価:180,000円(税別) A4判 234ページ 2014年10月発刊
収録特許件数 753件 検索期間(日米出願日/日本公開日/米国登録日):1993年1月~2014年3月末

ワイヤレス給電関連技術に関する米国登録特許調査レポート

冊子版 定価:90,000円、冊子+CD版:定価:180,000円(税別) A4判 110ページ 2013年5月発刊
収録特許件数 481件 検索期間(出願日/登録日):2000年1月~2012年7月末

SiCデバイス関連技術の最新動向分析調査 Part.2 PCT公開及び米国登録特許

冊子+CD版 定価:90,000円(税別) A4判 201ページ 2008年10月発刊 収録特許件数 670件
PCT検索期間(公開日):1995年1月~2008年4月末 米国検索期間(登録日):1995年1月~2007年12月末(Part.1収録外)

米国登録特許におけるSiCデバイス関連技術最新動向分析調査

Part.1 プロセス技術/デバイス技術

冊子+CD版 定価:90,000円(税別) A4判 167ページ 2006年9月発刊 収録特許件数 467件
検索期間(登録日):1995年1月~2005年12月末

各レポートの目次のご案内 (1)

1. はじめに	6
1-1-1. 本書の目的	6
1-1-2. 特許検索について	9
1-1-3. 解析軸および分類について	10
2. 心拍/脈拍測定に関する特許動向分析	30
2-1. 特許の全体動向	30
2-2. 解析軸1: 測定技術/応用技術とそれぞれの対象	31
2-3. 解析軸2: 測定対象/応用対象と機器形態の関連	36
2-4. 解析軸3: 測定の技術方式	38
2-5. 解析軸4: 測定の部位	41
2-6. 解析軸5: 要素技術	43
2-7. 心拍/脈拍測定技術に関する公開特許の出願人別動向	43
2-8. 上位出願人の特許出願と事業化の動向	49
*3章から5章までは2章と同じ構成になっています。	
3. 血圧測定に関する特許動向分析	94
4. 心電測定に関する特許動向分析	176
5. 血中酸素測定に関する特許動向分析	218
6. バイタルサインセンシングの日本特許出願動向のまとめ	253
収録特許一覧	254
◆上位出願人の項は、基本的に各社とも以下の(1)～(10)になっています。但し、(2)(3)など該当する公開特許の件数が少ない場合は省略した出願人もあります。	
(1) 事業化動向	
(2) 抽出特許の概要	
(3) 測定技術に関する公開特許の動向	
(4) 応用技術に関する公開特許の動向	
(5) 技術方式別公開特許の動向	
(6) 測定部位別公開特許の動向	
(7) 要素技術別公開特許の動向	
(8) 単独出願と共同出願	
(9) 抽出特許に関するまとめ	
(10) 登録特許の概要	

血糖値センサー技術に関する特許分析と事業化動向

1. グルコースセンサー技術の概要と発展の経緯	4
1-1. 糖尿病について	4
1-2. 血糖値測定器の歴史	5
1-2-1. 簡易血糖計による血糖自己管理 (SMBG)	5
1-2-2. 非侵襲血糖値測定と持続血糖測定 (CGM)	5
(1) 光学的測定	5
(2) 電気化学的測定	6
(3) インシュリンポンプと持続血糖測定 (CGM)	6
(4) 光学的SMBG/CGMの研究開発と事業化動向	7
2. 本レポートの特許検索についての解説	7
3. 米国登録特許の分析	9
3-1. 出願人分析	10
3-1-1. 出願人国籍別分析	10
3-1-2. 出願人別の出願件数	13
3-2. 技術区分による分析	16
3-2-1. 技術方式別分析	19
3-2-2. 測定部位別分析	24
3-2-3. 要素技術別分析	29
3-2-4. 課題別分析	30
3-2-5. 解決手段別分析	32
3-3. 上位出願人の特許	34
3-3-1. Sensys Medical Inc.	34
(1) Sensys Medicalおよびそれに関連する特許出願	34
(2) Sensys Medical関連特許のグルーピング	35
(3) 技術区分別の分布	35
(4) 事業化の動向	38
(5) 代表特許	39
*以下の5社も詳細は(1)から(5)まで同じ構成になっております。	
3-3-2. Cercacor Laboratories, Inc.	56
3-3-3. OptiScan Biomedical Corp.	68
3-3-4. InLight Solutions, Inc.	79
3-3-5. OrSense, Ltd.	90
3-3-6. Optix LP	100
*以下の詳細は「3. 米国登録特許の分析」と同じ構成になっております。	
4. 日本公開特許の分析	109
4-1. 日本公開特許の年別推移	109
4-2. 出願人分析	110
4-3. 技術区分による分析	117
4-4. 上位出願人の特許	135
4-4-1. 日立製作所	135
4-4-2. オリンパス	152
4-4-3. パナソニック	173
4-4-4. 東芝	196
5. 今後の非侵襲血糖測定の方角性	211
収録特許一覧	213

各レポートの目次のご案内 (2)

ワイヤレス給電関連技術に関する米国登録特許調査レポート

1. はじめに	5
2. ワイヤレス給電に関する米国特許の概要	7
3. ワイヤレス給電に関する米国特許の上位出願人	9
4. 技術分類による分析	10
(1) 給電方式による分類	10
(2) 応用分野による分類	13
(3) 課題による分類	16
(4) 解決手段による分類	17
5. 技術分類の相関による分析	18
(1) 給電方式と応用分野の相関分析	18
(2) 課題と解決手段の相関分析	24
6. 上位出願人のプロフィールと出願動向	26
6-1. セイコーエプソン、 ソニーモバイルコミュニケーションズ	26
6-2. Access Business Group International、Amway、 Splashpower	28
6-3. OBTech Medical	30
6-4. Automotive Technologies、 Intelligent Technologies	31
6-5. Powercast、FireFly Technologies、 ピッツバーグ大学	32
6-6. マサチューセッツ工科大学、WiTricity	33
6-7. City Univercity Hong Kong、CityU Research、 Convenient Power	34
6-8. Qualcomm、Powermat、Auckland Uniservices	34
7. 注目特許分析	36
8. 注目特許の解説	39
* 27社、1個人の特許78件分を収録	
9. 資料編	106

S i c デ バ イ ス 関 連 技 術 の 最 新 動 向 分 析 調 査 P a r t 2 P C T 公 開 及 び 米 国 登 録 特 許	1. 調査内容について	4
	2. PCT公開特許における全体分析	6
	2-1. 収集特許の概要	6
	2-2. PCT公開特許の技術区分別分析	7
	2-2-1. プロセス技術	8
	2-2-2. デバイス技術	9
	2-2-3. 結晶成長技術	11
	2-2-4. 回路・実装技術	13
	2-3. PCT公開特許の出願人別分析	15
	2-3-1. プロセス技術に関する出願人分析	16
	2-3-2. デバイス技術に関する出願人分析	19
	2-3-3. 結晶成長技術に関する出願人分析	23
	2-3-4. 回路・実装技術に関する出願人分析	26
	2-3-5. PCT公開特許の出願人国籍別分析	27
	3. PCT公開特許の注目特許分析	28
	3-1. プロセス技術	28
	3-2. デバイス技術	47
	3-3. 結晶成長技術	88
	3-4. 回路・実装技術	108
	4. 米国登録特許における全体分析	113
4-1. 収集特許の概要	113	
4-2. 米国登録特許の技術区分別分析	115	
4-2-1. プロセス技術	116	
4-2-2. デバイス技術	117	
4-2-3. 結晶成長技術	119	
4-2-4. 回路・実装技術	121	
4-3. 米国登録特許の出願人別分析	122	
4-3-1. プロセス技術に関する出願人分析	123	
4-3-2. デバイス技術に関する出願人分析	127	
4-3-3. 結晶成長技術に関する出願人分析	131	
4-3-4. 回路・実装技術に関する出願人分析	135	
5. 米国登録特許の注目特許分析	140	
5-1. プロセス技術	140	
5-2. デバイス技術	154	
5-3. 結晶成長技術	181	
5-4. 回路・実装技術	194	

各レポートの目次のご案内 (3)

1. 調査内容について	3	3-3-7. マイクロパイプ閉塞 (filling)	123
2. 全体分析	5	3-3-8. デバイス作成プロセス	123
2-1. 収集特許の概要	5	3-3-9. エピタキシャル結晶成長技術のための装置、治具	123
2-2. 技術区分別分析	6	3-4. その他 (2)	123
2-2-1. プロセス技術	7	3-4-1. 検出・保護	123
2-2-2. デバイス技術	10	3-4-2. デバイス実装	123
2-2-3. その他技術	11	3-4-3. 主回路	123
2-3. 出願人別分析	12	3-4-4. その他のデバイス	123
2-3-1. プロセス技術	12		
2-3-2. デバイス技術	17		
3. 注目特許分析	26		
3-1. プロセス技術	26		
3-1-1. ドライエッチング	26		
3-1-2. イオン注入・アニール方法/接合形成	27		
3-1-3. オーミックコンタクト	34		
3-1-4. MOS界面	41		
3-1-5. SOI基板製法/貼り合わせ	46		
3-1-6. MOSセルフアライメント	50		
3-1-7. JFET/MESFETセルフアライメント	56		
3-1-8. その他のプロセス技術	58		
3-2. デバイス技術	61		
3-2-1. ショットキーダイオード	61		
3-2-2. pn接合ダイオード	66		
3-2-3. Trench MOSFET	70		
3-2-4. Low Ron MOSFET	76		
3-2-5. 高耐圧Vertical MOSFET	83		
3-2-6. MOS高信頼化	84		
3-2-7. Vertical JFET	87		
3-2-8. Lateral MOSFET/JFET	92		
3-2-9. BJT	95		
3-2-10. Thyristor/GTO	98		
3-2-11. MESFET	101		
3-2-12. 複合デバイス	103		
3-2-13. その他のスイッチング素子	108		
3-2-14. スーパ接合ほか	109		
3-2-15. ターミネーション/パッシベーション	111		
3-2-16. IC化技術	117		
3-3. その他の技術 (1)	123		
3-3-1. 六方晶 (4H, 6H)	123		
3-3-2. ウエハ化 (スライス, 研磨など)	123		
3-3-3. バルク単結晶の製作技術のための装置	123		
3-3-4. CVDホモエピタキシャル成長 (4H, 6H)	123		
3-3-5. CVDヘテロエピタキシャル成長 (3C)	123		
3-3-6. その他の成長法	123		

CDの収録内容紹介

バイタルサインセンシング技術に関する特許分析と
事業化動向 Part.1 日本特許編のExcel収録項目

公報番号	公開日	
出願番号	出願日	
日本登録番号	登録日	発行日
分割の表示	原出願日	
優先出願番号	優先権主張日	
国際公開番号		
発明の名称		
国際特許分類		
FI		
Fターム		
要約原文		
測定/応用	測定対象	応用対象
機器形態		
技術方式大区分	技術方式	
測定部位大区分	測定部位	
要素技術		
査定	審判	
出願人1	国籍1	
出願人2	国籍2	
出願人3	国籍3	
出願人4	国籍4	
発明者		

冊子+CD版に付属するCDには、
本文PDFと収録特許の書誌デー
タを収めたExcelファイルが入っ
ています。Excelファイルは、
統計処理がしやすいようになって
おり、収録項目も、例えば最新の
「バイタルサインセンシング技術
に関する特許分析と事業化動向
Part.1 日本特許編」では左記の
項目からなっています。
他のレポートも、書誌情報と
分析手法に応じた分析結果から
なっています。

米国登録特許におけるSiCデバイス関連技術最新動向分析調査
Part1 プロセス技術/デバイス技術